

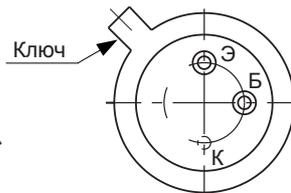
ДП КВАЗАР-ИС

ЭТИКЕТКА

Транзисторы:
2Т313А, 2Т313Б.

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы 2Т313А, 2Т313Б выполненные в металлостеклянном корпусе типа КТ-1-7 (ТО-18) и предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах.

Схемы расположения выводов



Масса не более 0,5 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25 ± 10 °С

| Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) | Буквенное обозначение | Норма | | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2Т313А | | 2Т313Б | |
| | | не менее | не более | не менее | не более |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кб} = 10$ В, $I_{э} = 1$ мА) | $h_{21э}$ | 30 | 120 | 80 | 300 |
| Обратный ток коллектора, мкА ($U_{кб} = 50$ В) | $I_{кб0}$ | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{эб} = 5$ В) | $I_{эб0}$ | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттера, В ($I_{к} = 150$ мА, $I_{б} = 15$ мА) | $U_{кэнас}$ | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_{к} = 150$ мА, $I_{б} = 15$ мА) | $U_{бэнас}$ | - | 1,3 | - | 1,3 |
| Ёмкость коллекторного перехода, пФ ($U_{кб} = 10$ В, $f = 10$ МГц) | $C_{к}$ | - | 12 | - | 12 |
| Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, нс ($U_{кб} = 5$ В, $I_{э} = 1$ мА, $f = 30$ МГц) | $t_{с}$ | - | 120 | - | 120 |

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. годных изделий:

Золото: _____ г

Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т313А, 2Т313Б соответствуют техническим условиям ЩЦЮ.336.049 ТУ.

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

Место для
штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена _____"
дата

Место для
штампа ОТК